⑲ 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

四公開特許公報(A)

平2-185016

⑤Int. Cl. 5
H 01 L 21/027

識別記号

厅内整理番号

❸公開 平成2年(1990)7月19日

7376—5F

H 01 L 21/30

311 L

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全10頁)

9発明の名称 投影光学装置

❷特 願 平1−5320

②出 願 平1(1989)1月12日

@発明者 谷口 哲夫

東京都品川区西大井1丁目6番3号 株式会社ニコン大井

製作所内

⑩出 願 人 株式会社ニコン

東京都千代田区丸の内3丁目2番3号

四代 理 人 弁理士 渡辺 隆男

en en 🕳

1. 発明の名称

投影光学装置

2. 特許請求の範囲

所定のパターンが形成されたマスクを照明手段により照明し、抜パターンの像を投影光学系を介して感光基板上に所定の結像状態で投影する装置において、前記投影光学系に入射する照明エネルギーの量に対応した値を入力する入力手段と:

前記投影光学系内の光学部材を保持する部材の 少なくとも1ケ所の温度変化を測定する測定手段 と;

前記入力手段により入力された値と前記測定手段により測定された温度変化とに基づいて、

前記投影光学系内の光学案子の温度変化を前記 投影光学系の熱伝達特性に基づいて算出する第1 演算手段と:

核算出された前記光学素子の温度変化に基づいて、前記投影光学系の結像特性の変動量を算出する第2演算手段と;

該算出された結像特性の変動量に基づいて前記 感光基板上のバターン像の結像状態を補正する補 正手段とを備えたことを特徴とする投影光学装置。 3.発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は、例えば半導体集積回路の製造に使用される諸光装置のうち、所定のパターン像の結像を行う投影光学装置に関するものであり、特にその結像特性の維持に関するものである。

〔従来の技術〕

従来、この種の投影光学装置(ステッパー、フォトリピータ)は、温度が±0.1でに保たれたチャンパ内に設置されており、外部の温度変化を受けないようになっていた。チャンパ内に設置された装置でも、投影光学系の付近若しくは投影光学系内部に温度センサを設置し、そのセンサ出たにむじて投影光学系の結像特性の補正を行う装置もある。また、照明光の入射に基づく温度変化による結像特性の補正については、例えば特別昭60元78454号公報に示されているように、投影

光学系へ入射するエネルギーを計算して、それに 基づき結像特性の変化を補正する方法が知られて いる

(発明が解決しようとする課題)

近年、半導体の集積度の増加に従い投影パター ンが微細化しており、チャンパの温度調整性能内 であっても投影光学系の結集特性の変動量(倍率、 焦点変動量等)が微細な投影パターン像に対して 相対的に大きくなり、結像性能が悪化するという 問題点があった。また、温度センサを用いて補正 を行う装置においても、ほとんどの場合測定され た温度変化に対して比例した量で補正を行ってい るのが普通である。ところが厳密にはチャンパの 温度がまず変化し、投影光学系の保持部材(鏡筒 等の金物)、投影光学系(レンズエレメント)へ と徐々に熱が移動していくため、前記の比例した 補正量では正確な補正はできないという問題点が ある。さらに、投影光学系は照明光を吸収して熱 変化を起こし、結像特性の変化が発生する。チャ ンバ温度変化と、照明光の吸収による温度変化を

対しては光電センサ等により入射エネルギーを求め、投影光学系へのエネルギー蓄積を演算し、結像特性の変化を求め補正する方式とするが、エネルギー蓄積の演算についても上記投影光学系の熱伝達特性を考慮に入れて行うことにより両者(投影光学系の鏡筒温度変化によるレンズエレメントの温度変化と、照明光の吸収によるレンズエレメントの温度変化)を分離して扱い、二重制御をかけないようにした。

(作用)

本発明においては、投影光学系保持部材の温度は直接温度センサにより測定し、投影光学系へ入射する照明光のエネルギーは光電センサ等で測定し、両者の測定結果を基に両者が作用した時の投影光学系内部(特にレンズエレメント)の温度を推定し、それに基づき結像特性の補正を行うため、チャンバ内の温度変化に基づく結像特性の変化と、観明光の吸収によるお像特性の変収による投影光できる。照明光の吸収による投影光であることができる。照明光の吸収による投影光

(課題を解決する為の手段)

かかる問題点を解決する為本発明においては、 温度センサにより投影光学系の保持部材の温度を 測定し、投影光学系内部の温度は温度センサの出 力に基づいて投影光学系の熱伝連特性を考慮した 演算式を用いて求め、捕正することにした。さら に、投影光学系の照明光の吸収による温度変化に

した熱が投影光学系保持部材を通って外部へ逃げていく現象を計算することにより求められるが、チャンパ温度が変化し、投影光学系保持部材の温度が変化して熱がレンズエレメントへ伝達する過程も、やはり投影光学系保持部材とレンズエレメントの勝のやりとりのため、照明光の吸収についても外部の温度変化も同じ式で表せ計算とである。 ち、結像特性への影響が大きないくつかのレンズエレメントについて上記計算を行い、それに対応と対した結像特性の変化を求めて補正を行えば、従来のような問題がなく補正が可能である。

(実施例)

第1図は、本発明の第1の実施例によるステッパーの主要な構成を示したものである。以下、第1図を参照しながら本実施例の構成を説明する。

装置の主要部分は、内部の空気温度と温度がほ は一定に保たれたチャンパ1の内部に設置されて いる。通常、このチャンパ1はチャンバ空調装置 1B、HEPA(High Efficient Particle Air)

フィルター1Cにより、チャンパ内の空気温度を 設定値に対して±0.1℃、湿度を設定値に対して ± 1 5 %程度に保つことができる。発熱源である 光源2は通常チャンパーの外部に設置されており、 光源2からの照明光はチャンパーと隔離される窓 (ダイクロイックミラー、ガラス板、又はレンズ 等の光学部材等)1Aを介して人射し、シャッタ 3Aを通って照明光の強度を露光エリア全域で均 一にするための光強度一様化照明系 4 を通り、ミ ラー5で反射された後、さらにコンデンサレンズ 6を通りレチクルRを照射する。レチクルRは回 路パターン等が描かれたマスクで、レチクルRを 通過した照明光は、投影レンズ系?を介してウェ ハW上にレチクルR上のパターンを結像、転写す る。ウエハWはウエハステージ部材(8、9X、 9 Y)上に真空吸着されており、順次移動しなが らステップ・アンド・リピート方式で露光される ようになっている。ウェハステージ部は不図示の 防張台上の定盤の上に設置されており、下から順 にY方向に1次元移動するYステージ9Y、X方

向に 1 次元移動する X ステージ 9 X 、さらにウエハWを載置して上下 (Z) 方向に微動する Z ステージ (ウエハ・ホルダを含む) 8 によって構成されている。

続いて、この種の装置に搭載されている結像特 性の補正機構の例を説明する。本実施例では、投 影レンズ系7の結像特性のうち、倍率と焦点位置 の補正の場合を示している。まず、倍率の補正機 構としては投影レンズ系7の内部の適当な1ヶ所 若しくは複数のレンズ間隔を密封した空気室16 を設けている。空気室16の内部の空気圧力をベ ローズポンプ、弁等で構成された圧力調整器15 でコントローラ10より指示された所定の値に保 つことにより倍率コントロールを行う。一方、焦 点位置の補正は投影レンズ系?とウエハWの距離 を焦点検出系で計測し、その計測値が一定値にな るように2ステージ8を駆動する焦点合わせ機構 にオフセットを持たせる方法で行う。その焦点検 出系は、LED、集光レンズ等から成る投光器1 7 と、SPD、集光レンズ等から成る受光器 1 8

とで構成されている。投光器17は第1図に示し ているように、ウエハWに斜め上方から光線を入 射し、その反射光を受光器18で受ける。ウェハ Wが所定位置から光軸方向にずれている場合、反 射光がシフトしずれ景を検出することができる。 ずれ量の信号はコントローラ10に送られ、コン トローラ10はウエハWが所定の位置に来るまで、 ウェハステージ部のZステージ8を光軸方向へ駆 動する駆動系19に信号を送り、常に投影レンズ 系7とウェハwの間隔を一定に保つ。オフセット を持たせるのは反射光の光路を光学素子(傾斜可 能な平行平板ガラス)によりシフトさせるか、す れ量の信号に電気的にオフセットを持たせる方法 による。本実施例では、結像特性として倍率、焦 点位置を取り上げたが、補正すべき結像特性とし てはディストーション、像面湾曲等を考えること もできる。また、補正手段としても本実施例の他 に、投影レンズ系7内の一部のレンズエレメント を光軸方向へ駆動する方法、レチクルRと投影レ ンズ系1の間隔を変える方法、投影レンズ系1の

上方又は下方空間に 2 枚の密封された平行平板が うスを設置し、その内部の圧力を変える方法、成 いはこれら各方法を適宜組み合わせた方法等が考 えられており、これらの方法を用いても同様であ る。

次に、本実施例の主要部分である投影光学系の保持部材(以下、鏡筒と呼ぶ)の温度変化と、照明光の投影光学系への吸収による温度変化とにより生じる結像特性の変化を求める方法の原理の説明を行うが、その前に、従来からの技術として知られている照明光吸収のみによる結像特性の変化を求める方法を簡単に説明する。

まず、簡略化して考えるためレンズエレメント 1個の場合について第2図に従って説明する。 照 明光の吸収による結像特性の変化は主に吸収の大 きいレンズ中心部と周辺部との温度勾配により発 生する。周辺部(鏡筒7A)の温度が一定と考え れば、温度勾配はレンズエレメント21の平均 な温度TLの温度変化分ムTLに比例すると考り られる。つまり、結像特性の変化はムTLと比例 関係にある。レンズエレメント21は第2図の上方から下方へ通過する照明光より熱量QIを吸収する。同時にレンズエレメント21は真論等の金属でできている鏡筒7Aに熱量Q0を放出している。レンズエレメント21に接している空気は熱伝導性が悪いので、空気への熱伝導量はここでは無視する。レンズエレメント21の温度TLは(Q!-Q0)の熱量に比例して変化する。つまり、

$$\frac{d T L}{d L} = K1 \cdot (Q1 - Q0) \cdots \cdots (1)$$

が成り立つ。ここで、 d TL / d t は、 TL の時間数分を衷しており、 K 1 は比例定数である。また、レンズエレメント 2 1 から鏡筒 7 A へ放出される熱量 Q 0 は両者の温度差に比例する。つまり、

が成り立つ。 ここで
$$K2$$
 は比例定数、 $T0$ は鏡筒 7 Aの温度である。 しかし、ここでは鏡筒 7 Aの温度は一定と過程しているため、 $TL-T0=\Delta$ TL となる。また、 d TL $/$ d t $=$ d Δ TL $/$ d

Q0 = K2. (TL - T0)

をレンズエレメント21の内部の温度が一定温度 TLとして計算したものであるが、厳密に熱の拡 散を計算して温度勾配を求める方法がより正確で あり、この方法も可能ではあるが、非常に複雑で あり、また上記の方法で十分特度が得られるため、 本方法で十分である。

次に、(4)式を実際の投影レンズ系7に適用する場合の説明を以下に行う。まず、(4)式の定数 KI、K2 を求めなければならない。これには Δ T L と QI の関係を知る必要があるが、実際定しは Δ T L に比例した結像特性の変化量を直接測定しまり、 1 との関係から KI、K2 を決定させる。つき性性の変化量と考えて良い。 ここでも、安全でに(4)式の Δ T L にあたる量が実際にはは投影レンズの Δ T L にあたるここでも、安全でに(4)式の 4 大 T て その合計で結像特性の変化量をで求めないが、結像特性に影響を及ぼすればレンズ系内の合計では像特性に影響を及びすればレンズ系のの合計では像特性に影響を及びすればレンズ系のの合計ではなどであり、は投影であるようとない、1個~3個程度の(4)式の組を用意し、3個程度の(4)式の組を用意し、1個~3個程度の(4)式の組を用意しため、1個~3個程度の(4)式の組を用意した。

t が成り立つ。以上と(1)、(2)式より、

$$\frac{d \Delta T L}{d L} = - K 1 \cdot K 2 \cdot \Delta T L + K 1 \cdot Q I \cdots (3)$$

が導ける。(3)式は、一階の微分方程式であるため、 時間毎の入力熱量Q!の値が知れれば、(3)式を解 くことにより A TL の値が求まる。(3)式の時刻 t における一般解は、

 $\Delta TL(t) = \exp(-t/k1k2) \Delta TL(0)$

+ K1
$$\int_0^t \exp \frac{-(t-\tau)}{K1K2} \cdot Q1 (\tau) d\tau$$
(4)

となる。ここで Δ T L (0) は 積分の 初期値に相当して、 r にはそのときの時刻しが代入される。この (4) 式は外部から熱量 Q I がレンズエレメント 2 1 に入った時に生じる平均温度変化量 Δ T L を表している。時間毎の熱量 Q I の値は、例えば 照明光の強度を S P D (シリコン・ホトダイオード)等で 測定することで 求めることができ、 (3) 式は良く知られている数値解法により解くことができ、 (4) 式に相当する解が得られる。以上説明した方法はレンズエレメントの平均的な温度変化量 Δ T L

その和を求めるだけで十分である。以上のように して結像特性の変化量を算出し、倍率については、 倍率変動をキャンセルする方向にコントローラ1 0から圧力調整器15に圧力信号を送り、焦点位 置変化に対しては追従する方向に受光器18にオ フセット信号を送り、補正を行う。

次に、上記照明光吸収による結像特性変化を求める原理的な方法を基に、鏡筒温度の変化を含めた本実施例の場合を説明する。上記の方法は鏡筒温度一定としたが、鏡筒温度をTCとし、基準となる温度をT0とすると、(2)式は、

$$\Delta TL = TL - T0 \qquad \cdots \cdots (6)$$

$$\Delta TC = TC - T0 \qquad \cdots \cdots (7)$$

とする。これより、(5)式は、

となる。また前記のようにdTL /dt=d△T

L / d l より、前記の(3)式にあたる式は、

$$\frac{d \Delta TL}{d t} = - K1 \cdot K2 \cdot \Delta TL$$

+ (K2·QI + K1·K2·ΔTC) ……(9) となる。同様に(9)式の時刻 t における一般解は、 ΔTL(t) = exp(-t/K1K2) ΔTL(0)

$$+\int_{0}^{t} \exp \frac{-(t-\tau)}{K1K2} \left\{ K2 \cdot QI \left(\tau\right) + K1 \cdot K2 \cdot \Delta TC(\tau) \right\} d\tau$$

··· ··· m

となる。仰式は外部から熱量(照明エネルギー量)QIと、温度変化量ΔTCとがレンズエレメント21に入った時に生じる平均温度変化量ΔTしを表しており、本発明の第1濱算手段に対応する。(9)式も(3)式と同様に数値計算で解くことができ、仰式に相当する解が得られる。ところで、温度変化による結像特性の変化の主な原因としては、レンズエレメントの理象に基づく結像特性の変化を多なが考えられる。この現象に基づく結像特性の変化ををΔX1とすると、この量はレンズエレメント

$$\Delta M = \overline{\Delta X T} + \overline{\Delta X L} = \sum_{i=1}^{n} \Delta X T_{i} + \sum_{i=1}^{n} \Delta X L_{i}$$

この図式において、 n は理論的には投影レンズ系 7 内のレンズエレメントの数だけ必要であるが、 実用上の特度等を考慮すると1~4 個程度で十分 である。ここで図式は本発明の第2 演算手段での 計算式に担当する。

さて、ΔΧti、ΔTLiはQD、QZ式から次のよう に表わされる。

Δ X Li ~ K 4i (Δ T Li – Δ T Ci) (5) また砌式は、

$$\Delta TLi(t) = \exp(-t/Kli \cdot K2i) \Delta TLi(0)$$

$$+\int_{0}^{t} \frac{-(t-\tau)}{\kappa_{1i} + \kappa_{2i}} \left\{ \kappa_{2i} \cdot Q_{1}(\tau) \right\}$$

··· ··· 06)

と表わせる。

21の平均的な温度変化量 Δ TLに比例すると考えて良い。一方、前記のように照明光の吸収による結像特性の変化は温度勾配によるもののため、レンズエレメントの平均的な温度TLと鏡筒温度TCとの差と考えて良い。照明光吸収による結像特性の変化量を Δ XLとすると、変化量 Δ XLは温度差(TLーTC)に比例する。つまり、(Δ TLー Δ TC)に比例する。以上のことからK3、K4 を係数とすると、

 Δ X L - K 4・(Δ T L $-\Delta$ T C) …… Ω と 表せる。 Δ T L は 仰式 (又は(4)式) により求められ、 Δ T C は 温度 測定器 1 3 により 直接求まるため、 Δ X T 、 Δ X L は 一種的に 決定される。

ところで実際の投影レンズ系 7 全体での結像特性の変化は、レンズェレメントのいくつか(n個)の和で表わせる。投影レンズ系 7 全体での 2つの原因による変化量をそれぞれ Δ X T、 Δ X Lとすると、総合結像特性変化量 Δ M は、以下のように表わせる。

この00、60、60式において未知の係数はKli、 K2i、K3i、K4iであり、これは予め実験や測定 等で求めておく必要がある。

また A T Ci は 旋筒 7 A の 温度センサが n 個 必要なことを 20 味する。この場合、 個式、 又は ぬ式で特定したレンズエレメントを保持する 縦筒部分近傍に各温度センサを取り付ければよい。 個式、 又は の式は 投影レンズ系 7 内のレンズエレメントのうち 温度変化に対して 比較的大きく 光学特性が変動するエレメント (又はエレメント群)の n 個を 進んで設定してある。

さて、次に個式の係数(パラメータ)Kli、K 2i、K3i、K4iを求める手順を簡単に説明する。 これらパラメータの求め方は、まず照射(露光) を行わずチャンパの設定温度を変えて△TCiと△ XTiの関係を調べる。この時、個式のK2i・Qi (r)の項及び図式の

--- 07)

n ΣΧLiの項は無視でき、変動量よりパラメータ i=l

K11、K2i、K3iを求めることができる。具体的には照射を行わずに投影レンズ系7全体の温度が十分に安定した状態からスタートし、チャンの設定温度を一定量(例えば0.2 ℃)変更し、変更しな特間毎にテストレチクル上の複数点に形成の関連な特性変化の過渡特性をみるため形成に形成の用値力や倍率、ディストーションチェック間のである。この場合、レチクルR(デストレチクル)を分した照射は全く行なわれていないの式中のQ1(て)も零の状態が続いているための式は Δ X Ti(0) = Δ T Li(0)・K3i として次のように表わる。

 $\Delta X Ti = exp(-t/K1i \cdot K2i) \Delta X Ti(0)$

+ K1i · K2i · K3i
$$\int_{0}^{t} \exp \frac{-(t-r)}{K1i \cdot K2i} \cdot \Delta TCi (r)$$

トと、照明光を吸収し易いレンズエレメントとは 異なる場合が多く、より簡単な形の演算式で補正 を行うことができる。つまり、温度変化による風 折率の変化のみが問題となるレンズエレメントに ついては照明光の吸収はないと考え、四式は無視 して良く、また伽式のK2·Q1(τ) も無視できる。 このため、対応するレンズエレメントの△XTiは 切式のように表わされ、対応するレンズエレメン トのみの変動量は AXI となる。また、照明光吸 収のみが問題となるレンズエレメントについては OD式が無視できる。より簡略化するために、照明 光吸収による温度上昇が鏡筒温度変化に比べて十 分大きく、鏡筒温度変化を無視できる場合は、09 式の代りに(4)式を使えば良い。この場合、パラメ ータの求め方も簡単となり、まず照射を行わずチ ャンパの設定温度の変更を行い、切式のパラメー タKli、Kli、K3i、の次定を行う。その後、切、 00式に基づいて ΔMを算出し、この ΔMが補正さ れるように圧力調整器15を作動させつつ照射を 行えば、残りの照明光吸収分のみに対応した変動

さらにテストレチクルを用いた計測により、総

(ただしΔ X Ti (0) は変動量の初期値)

合結像特性変動量 Δ M が求まっているから、図式 は

$$\Delta M = \overline{\Delta XT} = \sum_{i=1}^{n} \Delta XTi \qquad \dots \dots \dots \emptyset$$

となり、 Δ T Ci CC 対する各経過時間毎の Δ X I の各額定データ値に基づいて、例えば最小二乗調差近似で、3 つのパラメータ K 1 i、 K 2 i、 K 3 i が決まったところで照明光を照射し、総合結像特性変動量(Δ X I + Δ X L)と Δ T C 、Q I の関係より、残り K 4 i を求める。始めから(Δ X I + Δ X L)と Δ T C 、Q I の関係を調べることによりパラメータ K I i、 C i、 K I i、 K I i を求めるパラメータの数が少なく精度良く求められる。

以上は、一般的な場合の説明であるが、通常温 度変化により屈折率が変化し易いレンズエレメン

が表われるので、照明光吸収による結像特性変化 のパラメータK4iが決定できる。

次に、第1図、第2図を参照しながら鏡筒温度 の測定法と、照明光のエネルギーQ1 を求める方 法の説明を行う。温度センサ14A、14B、1 4 Cは直接鏡筒の金属に張りつけられている。鏡 筒7Aの温度勾配が問題となる場合は、温度セン サ14A、14B、14Cを鏡筒の内側に直接設 置しても良い。温度センサの内部の構造は第2図 に示してあるように瀕温体 2 2 が鏡筒 7 A に接し て取りつけられる。測温体は例えば白金抵抗体、 サーミスタ、熱電対等を用いることができる。測 退休22は熱伝源性の良いサーマルコンパウンド 23により覆われており、測温体22が鏡筒7A と同じ温度になるようにしてある。これらは温度 センサカバー25により保護されてがる。さらに、 外部の温度変化を遮断するため、温度センサカバ - 2 5 内部の空間 2 4 に断然材を充塡しても良い。 温度センサ14A、14B、14Cの取り付け位 置は、温度変化による屈折率変化の大きいレンズ

エレメントの保持部分近傍が望ましく、個数は切式の数、すなわち、の式のi(1~4)の数だけ用いるのが望ましいが、特度が保証できる範囲で減らすことも可能である。温度センサ14A、14B、14Cからの各測定信号は、温度測定器13により所定の基準温度Toからの温度変化量ムTCiに変換され、温度変化量ムTCiの各情報はコントローラ10へ送られる。

一方、照明光のエネルギーQ!(t)についてはレチクルRの交換毎、或いはレチクルRのパターン転写領域を制限するレチクルブラインドの位置変更毎に、ステージ9X、9Yに設けられた照度センサ11を投影レンズ系7の下へ移動させ、レチクルRのパターン転写領域を通って投影像では動きを取り、このEをQ!の測定に用いる。 師式 といるの Q!(t) は、シャッタ3Aの開閉状態によりQ!(t) = 0、またはQ!(t) = Q! となるため、コントローラ10はシャッタ制御回路3Bからシャッタ開閉状態に関する情報を入力する。

ーQ! を測定する。ステップ 1 0 0 は通常レチクルRの交換のたびに実行されるが、光源がエキシマレーザのようにパルス毎に強度変化するものは、あらかじめ測定しておくことができないため、露光光の一郎をレチクルの手前で分岐させて、常に光量モニターしておく必要がある。

ステップ104ではシャッター3人の開閉状態の情報が作られる。ここで光波2が連続発光する場合、開閉情報の作り方としては2通りの方法が考えられる。その1つは特開昭60~78454号公報にも開示されているように、一定のサンプ時間のデューティ比Du(0~1.0)を作り出す方法であり、もう1つは特開昭63~58349号公報に関示されたように、シャッターの最低開時、公報に関示されたように、シャッターの最低開時、シャッター3人が開いているときは論理値「1」、閉じているときは論理値「0」をサンプリングは行りになり、ほぼリアルタイムな流

上記のようにコントローラ10は、照度センサ11及びシャッタ制御回路3Bより信号を得てQI(t)を計算する。コントローラ10は、ATCI及びQI(L)より総合結像特性変勢量AMを計算する。過常、コントローラ10は温度変化、照明光吸収以外の原因についても補正を行っている。大気圧力、チャンパ空気温度(鏡筒温度ではない空気の温度)、温度等の環境条件を測定器12で測定し、この信号をコントローラ10に送る。これらの計測値は略リアルタイムで結像特性に影響を及ぼすので、環境条件変動に比例した結像特性の変動を示すため、予め実験若しくはシミュン等で求めた比例定数K5に従い結像特性の変化量をK5・AMの資算で計算する。

次に、コントローラ10内に設けられた各種浅 算式による代表的な制御の流れを第3図を参照し てさらに説明する。第3図はコントローラ10内 の演算プロセッサーが実行するプログラムにも相 当している。

まずステップ100において照明光のエネルギ

可能である。

商、その他シャッター3Aの開閉情報の作り方としては、シャッター3Aの開時間の値下。をシャッター開放時に出力し、シャッター3Aの閉時間の値で、をシャッター開放時に出力する方法もある。

次のステップ106では、入力したシャッタ開閉情報Ds、エネルギーBに基づいて、サンプリング時における入力エネルギー登、すなわち入力 熱量Q!(t)を算出する。ここでDs=「1」のときはQ!(t)=Ql=A・B(C)+ でAは係数)となり、Ds=「0」のときはQ!(t)=0となる。尚、他の開閉情報の作り方を採用する場合、デューディ比Duを用いるときは各サンプリング時間Ts毎にQl=A・B・Du(ただしの、開時間Tcを用いるときは、Toが出力された時でQl=A・B・To(ただしA・は係数)を計算し、ではに対している。またパルス光の場合は、一定の

サンプリング時間 (3~5秒) Ts 毎に

Q
$$1 = 2 \cdot \begin{cases} Ts \\ E \end{cases}$$
 を計算することになる。

以上のステップ 1 0 0 ~ 1 0 6 は、本発明の入力手段を構成する。

さて、次のステップ108では、その時点で温度センサにより計測(ステップ110)された温度変化量 A T Ci と、ステップ106で計算されたQ!(t) とを過式に代入(実際には微分方程式を数値計算することにより演算)し、各レンズエレメントに対応したn個(i = 1、2 -- n)の式を計算して、各エレメント毎の平均的な温度変化量ATLi(t)を求める。

引き続きコントローラ10の計算器は、ステップ112で個式、個式の計算を行なう。この際、先にも説明した通り、特定したレンズエレメントによっては個式が無視できるものもあるが、それは計算器内で予め設定しておけばよい。以上のステップ108は本発明の第1演算手段に対応し、ステップ112以降は第2演算手段に対応する。

原因が何であれ熱変化に起因するものは全て含まれている。この場合、温度センサを熱膨張が問題となる装置部分に貼り付けて、結像特性の変動と温度変化との対応を付けて(予め実験等で対応付けた式を用いて)補正を行うこともできる。このことより、上述のレンズエレメントの屈折率変化以外の原因に対しても十分対応できる。また、投影レンズ系7のみを他の装置とは別に温度調整を行う方法も提案されているが、完全に温度調整を行うことは困難であるため、本実施例の方法と併用すると良い。

以上、本発明の実施例では、照明光による温度 上昇と、周囲温度変化に基づく鏡筒温度変化とは、 温度現象であるために単純な加法計算が成り立た ず、両者を同時に計算式中に取り込んで演算する 手法をとった。しかし互いの変化が微小で単純な 加法計算が成り立つ場合は、照明光の吸収で生じ る温度上昇に起因した結像特性変化と、周囲温度 変化、鏡筒温度変化に基づく結像特性変化とを別 々に求め、単純に加え合わせてもよく、この方法 次のステップ114では、図式に基づいて総合結像特性変化量ΔMを計算し、その他の環境条件による変動も同時に補正する場合は、ステップ116で環境測定値に応じて変化する係数K5を取り込んで、最終的な変化量K5・ΔMを圧力調整器15、焦点検出系18へ出力する。圧力調整器15は、その変化量K5・ΔMに対応した倍率誤差を打ち消す方向に圧力値を補正し、焦点検出系18は、その変化量K5・ΔMに対応した焦点誤差を打ち消す方向にオフセットを働かせる。

以上の実施例では、温度変化による結像特性変化をレンズエレメントの屈折率変化と考えていたが、他にレンズエレメントの形状変化、鏡筒の無膨張、装置の熱膨張によるレチクルとレンズ間隔の変化、または鏡筒内部の空気温度の変化等が考えられる。しかしながら、本実施例による方法では、結像特性の変化と温度変化を熱伝達の式である鍋式又は鍋式により対応付けて(鍋、鍋式中の各パラメータは実際の結像特性変化と温度変化により求めて)いるため、

の方が簡単である。

〔発明の効果〕

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の実施例による縮小投影型電光 装置 (ステッパー) の構成を示す機略図、第2図 は実施例による投影光学系の一部の構造を示す断 面図、第3図は補正制御の代表的な演算シーケン

スを示すフローチャート図である。

(主要部分の符号の説明)

7 …投影光学系、

10…コントローラ、

11…照度センサ、

13…温度测定器、

14A~14C…温度センサ、

15…圧力調整器、

16…空気室、

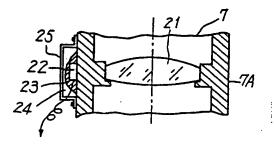
18…受光器(ウエハ位置検出器)、

R…レチクル、

₩…ウェハ。

出願人 株式会社 ニコン

代理人 弁理士 渡辺 隆男



第 2 図

